2SB891 エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ 低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp. Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor

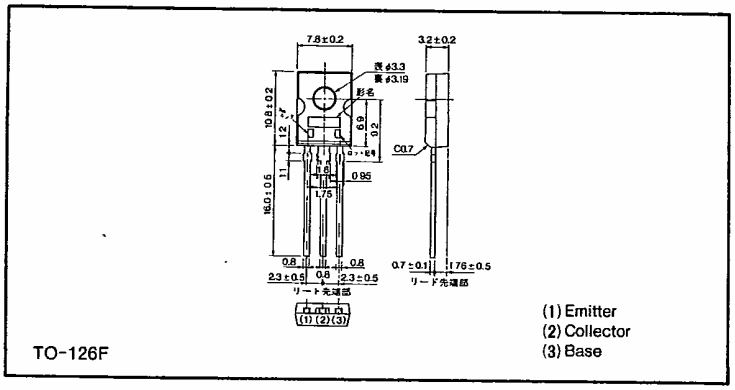
● 特長

1) 裏面もモールドで覆われており絶縁が不要である。
2) V_{CE}=−32V, $I_{C\,MAX}$=−2A, 5Wタイプの汎用である。
3) 2SD1189とコンプリである。

● Features

1) The rear surface of this device is also molded, eliminating the need for insulation.
2) General-purpose design rated at V_{CE}=−32V, I_{CMax}=−2A, P_{CMax}=5W
3) Complementary pair with 2SD1189

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−32	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−2	A
コレクタ損失	P_C	5	W (Tc=25℃)
接合部温度	Tj	150	℃
保存温度範囲	Tstg	−55～150	℃

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	−32	—	—	V	I_C=−1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	−40	—	—	V	I_C=−50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	−5	—	—	V	I_E=−50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	−1	μA	V_{CB}=−20V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	−1	μA	V_{EB}=−4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	−0.5	−0.8	V	I_C/I_B=−2A/−0.2A
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	V_{CE}/I_C=−5V/−500mA*
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f_T	—	100	—	MHz	V_{CE}=−5V, I_E=500mA
出力容量	C_{ob}	—	50	—	pF	V_{CB}=−10V, I_E=0, f=1MHz

* パルス測定

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82～180	120～270	180～390

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク
		記号	
		基本発注単位(個)	1 000
2SB891	PQR		◎

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

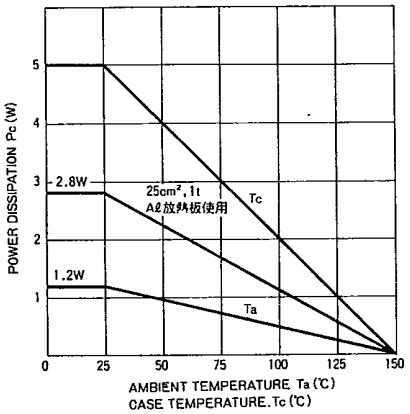


Fig.1 電力軽減曲線

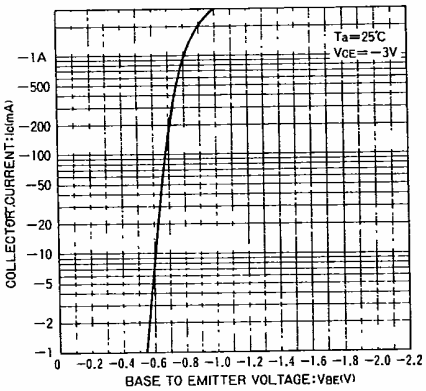


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

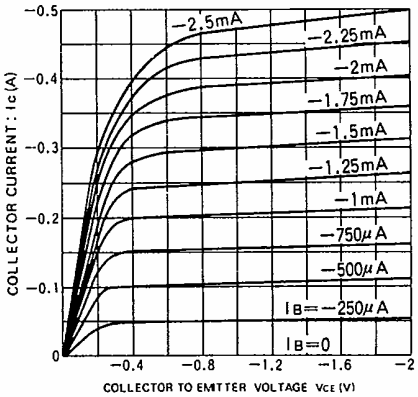


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

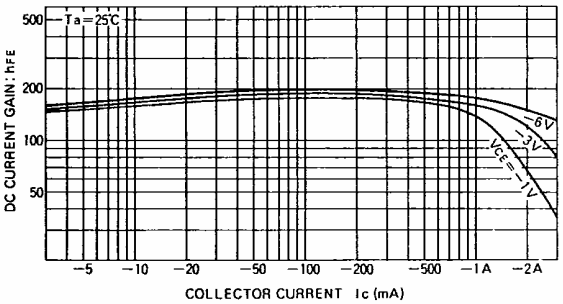


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

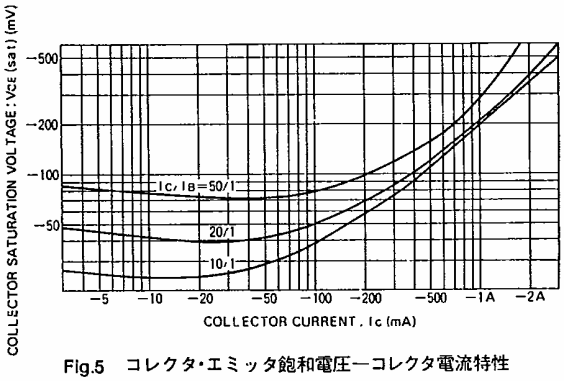


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

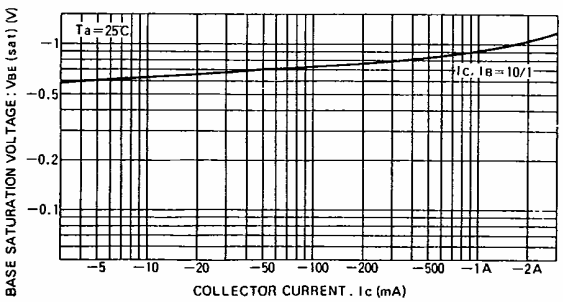


Fig.6 ベース・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

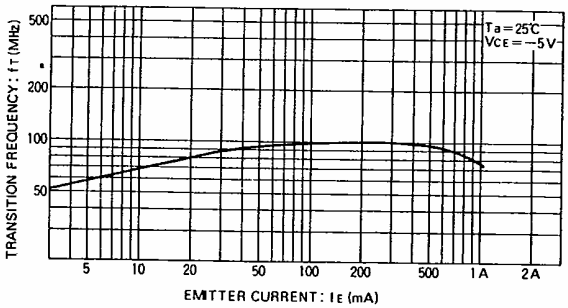


Fig.7 利得帯域幅積ーエミッタ電流特性

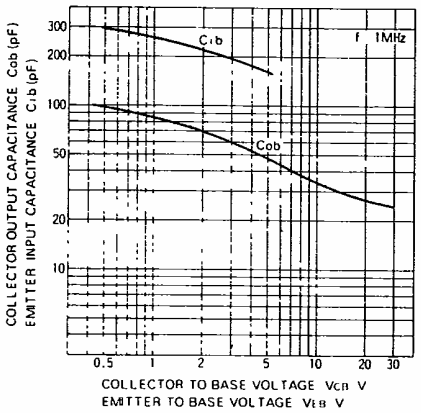


Fig.8 入出力容量ー電圧特性

ROHM